

トランジスタ

2SD951

## 2SD951

シリコン NPN 三重拡散メサ形/Si NPN Triple Diffused Junction Mesa

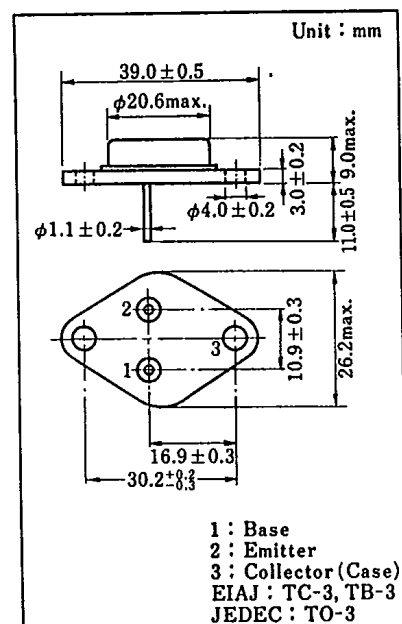
電源直結式水平偏向出力用/Line-Operated Horizontal  
Deflection Output

## ■ 特 徴/Features

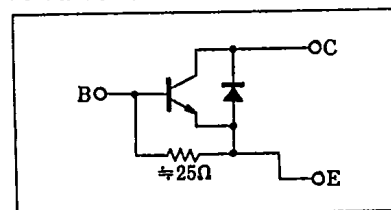
- コレクタ・エミッタ電圧  $V_{CES}$  が高い。/High  $V_{CES}$
- セン頭コレクタ電流  $I_{CP}$  が大きい。/High  $I_{CP}$
- ダンパダイオード内蔵。/Built-in damper diode on chip

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

| Item                              | Symbol    | Value           | Unit             |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|------------------|
| コレクタ・ベース電圧                        | $V_{CBO}$ | 1500            | V                |
| コレクタ・エミッタ電圧                       | $V_{CES}$ | 1500            | V                |
| エミッタ・ベース電圧                        | $V_{EBO}$ | 5               | V                |
| せん頭コレクタ電流                         | $I_{CP}$  | 5               | A                |
| コレクタ電流                            | $I_C$     | 3               | A                |
| コレクタ損失 ( $T_c=25^\circ\text{C}$ ) | $P_C$     | 65              | W                |
| 接合部温度                             | $T_J$     | 130             | $^\circ\text{C}$ |
| 保存温度                              | $T_{stg}$ | $-65 \sim +130$ | $^\circ\text{C}$ |



内部接続図/Connection Diagram

■ 電気的特性/Electrical Characteristics ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

| Item          | Symbol        | Condition                                                           | min. | typ. | max. | Unit          |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------------|
| コレクタしや断電流     | $I_{CBO}$     | $V_{CB}=750\text{ V}, I_E=0$                                        |      |      | 50   | $\mu\text{A}$ |
|               |               | $V_{CB}=1500\text{ V}, I_E=0$                                       |      |      | 1    | mA            |
| エミッタ・ベース電圧    | $V_{EBO}$     | $I_E=500\text{ mA}, I_C=0$                                          | 5    |      |      | V             |
| 直流電流増幅率       | $h_{FE}$      | $V_{CE}=10\text{ V}, I_C=2.5\text{ A}$                              | 3    |      | 12   |               |
| コレクタ・エミッタ飽和電圧 | $V_{CE(sat)}$ | $I_C=2.5\text{ A}, I_B=0.8\text{ A}$                                |      |      | 5    | V             |
| ベース・エミッタ飽和電圧  | $V_{BE(sat)}$ | $I_C=2.5\text{ A}, I_B=0.8\text{ A}$                                |      |      | 1.5  | V             |
| 下降時間          | $t_f$         | $I_C=2.5\text{ A}, I_{Bend}=0.8\text{ A}, L_B=5\text{ }\mu\text{H}$ |      |      | 0.9  | $\mu\text{s}$ |
| 蓄積時間          | $t_{stg}$     |                                                                     |      | 11   |      | $\mu\text{s}$ |
| ダイオード順特性      | $V_F$         | $-I_C=4\text{ A}, I_B=0$                                            |      | 1.7  |      | V             |

## トランジスタ

2SD951

T-33-11

